



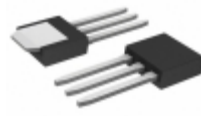






	<h2 style="color: #E67E22;">GP1M006A070FH</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	GP1M006A070FH
	Hersteller / Marke:	Global Power Technologies Group
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 700V 5A TO220F
Datenblätter:	 GP1M006A070FH.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 1953 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	GP1M006A070FH
Hersteller	Global Power Technologies Group
Beschreibung	MOSFET N-CH 700V 5A TO220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1953 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	39W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	700V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.65 Ohm @ 2.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1500pF @ 25V
Verpackung	Tube

GP1M006A070FH ist neu im Original, Suche GP1M006A070FH Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie GP1M006A070FH Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen. Anfrage GP1M006A070FH: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>GP1M008A025CG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 250V 8A DPAK</p>	 <p>GP1M006A065PH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 650V 5.5A IPAK</p>	 <p>GP1M007A090H Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 900V 7A TO220</p>	 <p>GP1M006A065FH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 650V 5.5A TO220F</p>
 <p>GP1M008A025FG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 250V 8A TO220F</p>	 <p>GP1M006A065CH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 650V 5.5A DPAK</p>	 <p>GP1M006A065F Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 650V 5.5A TO220F</p>	 <p>GP1M006A070F Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 700V 5A TO220F</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ GP1FA501RZ	↔ GP1FA501TZ	⇒ GP1FA502RZ	D GP1FA513TZ	↔ GP1FA51TKOF
⊣ GP1FA550RZ	⊗ GP1FA550TZ	D GP1FA551	⇒ GP1FA551TZ	↔ GP1FA553RZ0F
⊗ GP1FA553RZ0F	⊣ GP1FA553TZ0F	⊗ GP1FAV31TK0F	↔ GP1FAV50RK0F	↔ GP1FAV50TK0F
D GP1FAV51TK0F	⊗ GP1FD320TP0F	⊣ GP1FM313TMF5	⊗ GP1FM313TZMF	↔ GP1FSV51TK0F
⇒ GP1L53VJ000F	↔ GP1L57J0000F	⊗ GP1M003A050FG	⊣ GP1M003A080CH	↔ GP1M003A090C
↔ GP1M007A090H	⇒ GP1M008A025PG	D GP1M009A020FG	⊗ GP1M009A090N	⊣ GP1M010A060H
⊗ GP1M010A080FH	D GP1M011A050FH	⇒ GP1M013A050H	↔ GP1M016A025CG	↔ GP1M016A060F
⊣ GP1M016A060H	⊗ GP1S092HCPI	↔ GP1S092HCPIF	⇒ GP1S092HCPIF	↔ GP1S092HCPKF
⊗ GP1S093HCZ	⊣ GP1S093HCZ0F	⊗ GP1S093HCZ0F	D GP1S093HCZ0F	↔ GP1S094HCZ0F
↔ GP1S094HCZ0F	⊗ GP1S094HCZ0F	⊣ GP1S096HCZ	⊗ GP1S096HCZ0F	↔ GP1S096HCZ0F

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited